

Физика и техника полупроводников, 2015, том 49, выпуск 11

XIX симпозиум "Нанозлектроника и Нанозлектроника", Нижний Новгород, 10-14 марта 2015 г.

Аверин С.В., Кузнецов П.И., Житов В.А., Захаров Л.Ю., Котов В.М., Алкеев Н.В., Гладышева Н.Б.

**XIX симпозиум Нанозлектроника и нанозлектроника", Нижний Новгород, 10-14 марта 2015 г.
Селективное детектирование УФ-излучения на основе низкоразмерных гетероструктур
ZnCdS/ZnMgS/GaP и ZnCdS/ZnS/GaP**

1441

Большаков А.С., Чалдышев В.В., Бабичев А.В., Кудряшов Д.А., Гудовских А.С., Морозов И.А.,
Соболев М.С., Никитина Е.В.

**Исследование структур с множественными квантовыми ямами InAs/GaAs методом
спектроскопии электроотражения**

1448

Антонов А.В., Дроздов М.Н., Новиков А.В., Юрасов Д.В.

**Сегрегация Sb в Ge эпитаксиальных слоях и ее использование для селективного
легирования структур на основе германия**

1453

Яблонский А.Н., Байдакова Н.А., Новиков А.В., Лобанов Д.Н., Шалеев М.В.

**Спектры возбуждения и кинетика фотолюминесценции в структурах с
самоформирующимися Ge(Si) наноструктурами**

1458

Юрасов Д.В., Бобров А.И., Данильцев В.М., Новиков А.В., Павлов Д.А., Скороходов Е.В., Шалеев
М.В., Юнин П.А.

**Влияние условий роста и отжига на параметры релаксированных слоев Ge/Si(001),
полученных методом молекулярно-пучковой эпитаксии**

1463

Юнин П.А., Дроздов Ю.Н., Дроздов М.Н., Королев С.А., Охапкин А.И., Хрыкин О.И., Шашкин В.И.

Слои Si₃N₄ для in situ пассивации транзисторных структур на основе GaN

1469

Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е., Винниченко М.Я., Балагула Р.М., Кулагина М.М., Васильев А.П.

**Влияние поперечного электрического поля и температуры на поглощение света в
туннельно-связанных квантовых ямах GaAs/AlGaAs**

1473

Калентьева И.Л., Звонков Б.Н., Вихрова О.В., Данилов Ю.А., Демина П.Б., Дорохин М.В.,
Здоровейцев А.В.

**Оптические и магнитотранспортные свойства структур InGaAs/GaAsSb/GaAs, легированных
магнитной примесью**

1478

Казанов Д.Р., Кайбышев В.Х., Давыдов В.Ю., Смирнов А.Н., Жмерик В.Н., Кузнецова Н.В., Копьев
П.С., Иванов С.В., Шубина Т.В.

Температурное переключение резонаторных мод в микрокристаллах InN

1484

Колпаков Д.А., Звонков Б.Н., Некоркин С.М., Дикарева Н.В., Алешкин В.Я., Дубинов А.А.

**Полупроводниковый лазер с туннельным p-n-переходом и выходом излучения через
подложку**

1489

Шмагин В.Б., Кудрявцев К.Е., Новиков А.В., Шенгуров Д.В., Юрасов Д.В., Красильник З.Ф.

Применение техники годографа к диагностике диодных структур

1492

Малышева Е.И., Дорохин М.В., Ведь М.В., Кудрин А.В., Здоровейцев А.В.

**Циркулярно-поляризованная электролюминесценция светоизлучающих диодов
InGaAs/GaAs/(A^{III},Mn)B^V на основе структур с туннельным барьером**

1497

Травкин В.В., Пахомов Г.Л., Лукьянов А.Ю., Стужин П.А.

Тандемные фотовольтаические ячейки с композитным соединительным слоем

1501

Оболенская Е.С., Чуринов А.Ю., Оболенский С.В., Мурель А.В., Шашкин В.И.

Радиационная стойкость планарных диодов Ганна с delta-легированными слоями

1507

Полищук О.В., Попов В.В., Otsuji T.

**Сверхизлучательное усиление терагерцового излучения при возбуждении плазмонных мод
в инвертированном графене с планарным распределенным брэгговским микрорезонатором**

1516

- Мездрогина М.М., Еременко М.В., Петров В.Н., Теруков Е.И., Левицкий В.С., Кайдашев Е.М., Лянгузов Н.В.
Влияние процессов самоорганизации, дефектов, примесей, а также автокаталитических процессов на параметры пленок и наностержней ZnO 1521
- Талалаев В.Г., Новиков Б.В., Цырлин Г.Э., Leipner H.S.
Температурное тушение спонтанного излучения в туннельно-инжекционных наноструктурах 1531
- Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**
 Левицкий В.С., Леньшин А.С., Середин П.В., Теруков Е.И.
Исследование процессов деградации оптических свойств мезо- и макропористого кремния при воздействии имитатором солнечного излучения 1540
- Физика полупроводниковых приборов**
 Савельев А.В., Коренев В.В., Максимов М.В., Жуков А.Е.
Выжигание пространственных дыр и стабильность спектра генерации многочастотного лазера с квантовыми точками 1546
- Соколова З.Н., Пихтин Н.А., Тарасов И.С., Асрян Л.В.
Сравнительный анализ влияния электронного и дырочного захвата на мощностные характеристики полупроводникового лазера 1553
- Иванов П.А., Коньков О.И., Самсонова Т.П., Потапов А.С., Грехов И.В.
Динамические характеристики дрейфовых диодов с резким восстановлением на основе 4H-SiC 1558
- Цацульников А.Ф., Лундин В.В., Сахаров А.В., Заварин Е.Е., Усов С.О., Николаев А.Е., Сеницын М.А., Черкашин Н.А., Карпов С.Ю.
Исследование влияния дизайна активной области монолитных многоцветных светодиодных гетероструктур на спектры и эффективность их излучения 1563
- Егоров А.Ю., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Бабичев А.В., Неведомский В.Н., Бугров В.Е.
Концепции создания монолитных метаморфных вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 1300-1550 нм 1569
- Егоров А.Ю., Бабичев А.В., Карачинский Л.Я., Новиков И.И., Никитина Е.В., Tchernycheva M., Софронов А.Н., Фирсов Д.А., Воробьев Л.Е., Пихтин Н.А., Тарасов И.С.
Генерация многопериодных квантово-каскадных лазеров в спектральном диапазоне 5.6 -5.8 мкм при токовой накачке 1574
- Джиоев Р.И., Кавокин К.В., Кусраев Ю.Г., Полетаев Н.К.
Динамика рекомбинации носителей в полупроводниковой лазерной структуре 1578